

II. – DESCRIPTION DES CIRCUITS

A. HAUTE FRÉQUENCE

1. Dans la position cadre.

Le signal haute fréquence est reçu sur un cadre antiparasite constitué par un bâtonnet de ferrite long de 200 mm, portant les bobines d'accord PO et GO.

2. Sur la position antenne.

Le cadre est hors service et des bobines d'accord antenne PO et GO se substituent à lui.

La mise en circuit des 2 gammes PO et GO est assurée par un commutateur à clavier à 4 touches.

La touche antenne est uniquement utilisée pour la réception sur antenne voiture.

L'étage oscillateur modulation est constitué par un transistor SFT 108.

L'ensemble composé des commutateurs, des bobines et des trimmers ajustables, constitue le bloc haute fréquence deux gammes.

B. FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE

Deux transistors Sc 2 (SFT 107) et Sc 3 (SFT 106) sont utilisés pour l'amplification de fréquence intermédiaire. Les transformateurs de liaison à pôts fermés sont réglés sur 477 kc/s.

Ces transformateurs sont repérés sur les blindages respectivement par RB 1 - RA 2 - RA 3.

Chacun des deux étages possède un circuit de neutrodynage par capacité. C 7 et C 11 ramènent sur les bases des transistors Sc 2 et Sc 3 un signal en opposition de phase.

C. DÉTECTION ET COMMANDE AUTOMATIQUE DE GAIN

La détection du type classique est assurée par une diode au germanium D 2. Ce montage à basse impédance utilise comme résistance de charge, après un premier filtre haute fréquence composé de R 33 et C 22, le potentiomètre de volume sonore P 1 et la résistance R 14 - P 1. La capacité de détection C 12 est de 10 nF.

Le gain des étages de fréquence intermédiaire est commandé par une tension continue positive prélevée sur la résistance de détection.

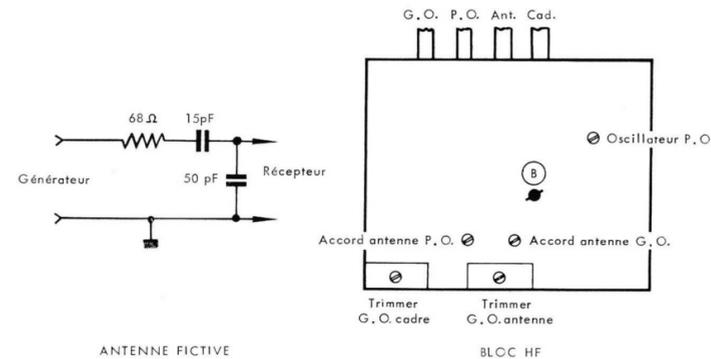
D. PRÉAMPLIFICATEUR BASSE FRÉQUENCE ET DÉPHASEUR

Le signal attaque la base du transistor Sc 7 (SFT 152) à travers une capacité de 6,4 microfarad, le volume sonore est dosé par le potentiomètre P 1.

L'étage déphaseur est composé du transistor Sc 6 (SFT 152) et d'un transformateur T 1 - 1071 B dont le noyau est constitué de tôles à grains orientés.

E. ÉTAGE DE SORTIE BASSE FRÉQUENCE

L'étage de sortie basse fréquence utilise deux transistors Sc 4 et Sc 5 (SFT 123) montés en push-pull classe B, sans transformateur de sortie.



III. – RÉGLAGES

A. RÉGLAGE DE LA DIODE D'AMORTISSEMENT

Le point A étant à la masse.

Après avoir mesuré la tension de l'anode de D 1, ajuster R 6 de façon à obtenir sur le collecteur du transistor Sc 2, une tension inférieure de 1 V à celle de l'anode de D 1. Cela permet de rendre non conductrice la diode D 1 pour les faibles injections. Pour les fortes injections, la diode D 1 élargit la bande passante — par amortissement du transformateur RB 1 et assure une meilleure musicalité sur les stations locales.

B. TABLEAU DE RÉGLAGE

Réglage	Fréquence	Commutation	Position C.V.	Point d'attaque	Réglage à effectuer	Observations
Fréquence intermédiaire	477 kc/s	Touches PO et CAD enclenchées	Fermé	Dessouder le fil noir du cadre et injecter au point B du schéma	Régler les 3 bobines RB 1-RA 2-RA 3	Répéter plusieurs fois l'opération pour arriver au minimum d'injection
PO Position cadre	1 ^o 520 kc/s	Touches PO et CAD enclenchées	Fermé	Ressouder le fil noir Boucle rayonnante	Noyau oscillateur PO sur bloc HF	Répéter plusieurs fois l'opération pour arriver au minimum d'injection
	2 ^o 1.610 kc/s		Ouvert	Boucle rayonnante	Trimmer sur C.V. oscillateur	Maximum de signal et minimum d'injection
	3 ^o 574 kc/s		Repère cadran	»	Bobine PO du cadre	
	4 ^o 1.400 kc/s		Repère cadran	»	Trimmer sur C.V. accord	
Pas de réglage oscillateur en GO Position cadre	1 ^o 170 kc/s	Touches GO et CAD enclenchées	Repère cadran	Boucle rayonnante	Bobine GO du cadre	Maximum de signal
	2 ^o 250 kc/s		Repère cadran	»	Trimmer accord cadre GO sur bloc HF	
PO Position antenne	574 kc/s	Touches PO et antenne enclenchées	Repère cadran	Prise antenne par l'intermédiaire de l'antenne fictive	Noyau de la bobine Accord antenne PO sur bloc HF	Maximum de signal
GO Position antenne	170 kc/s	Touches GO et antenne enclenchées	Repère cadran	Prise antenne par l'intermédiaire de l'antenne fictive	Noyau de la bobine Accord antenne GO sur bloc HF	Maximum de signal
	250 kc/s					

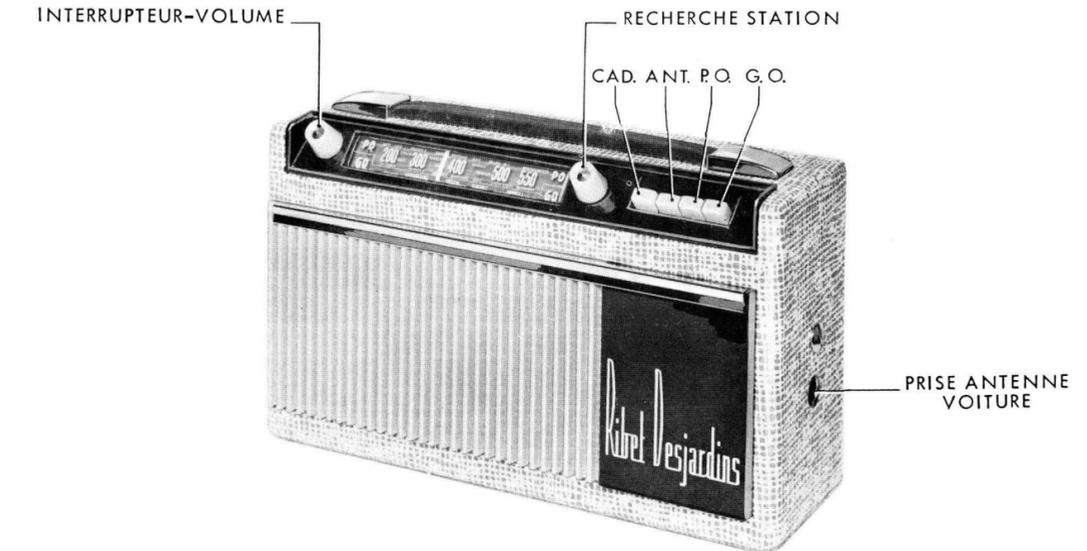
IV. – DÉMONTAGE DU CHASSIS

- Retirer les deux vis à bois maintenant le panneau arrière par le dessous.
- Enlever en tirant, les boutons du potentiomètre et de recherche stations.
- Dévisser, à l'aide d'une pince chaînette, les écrous fendus retenant le cadran.
- Dévisser, à l'aide d'une pièce de monnaie, les deux vis latérales du coffret.
- De l'arrière, tirer à soi le châssis par le bas, pour dégager la partie cadran.

RIBET DESJARDINS NOTICE DE MAINTENANCE

13 A 19, RUE PERIER, MONTROUGE (SEINE) TEL. ALESIA 24-40 +

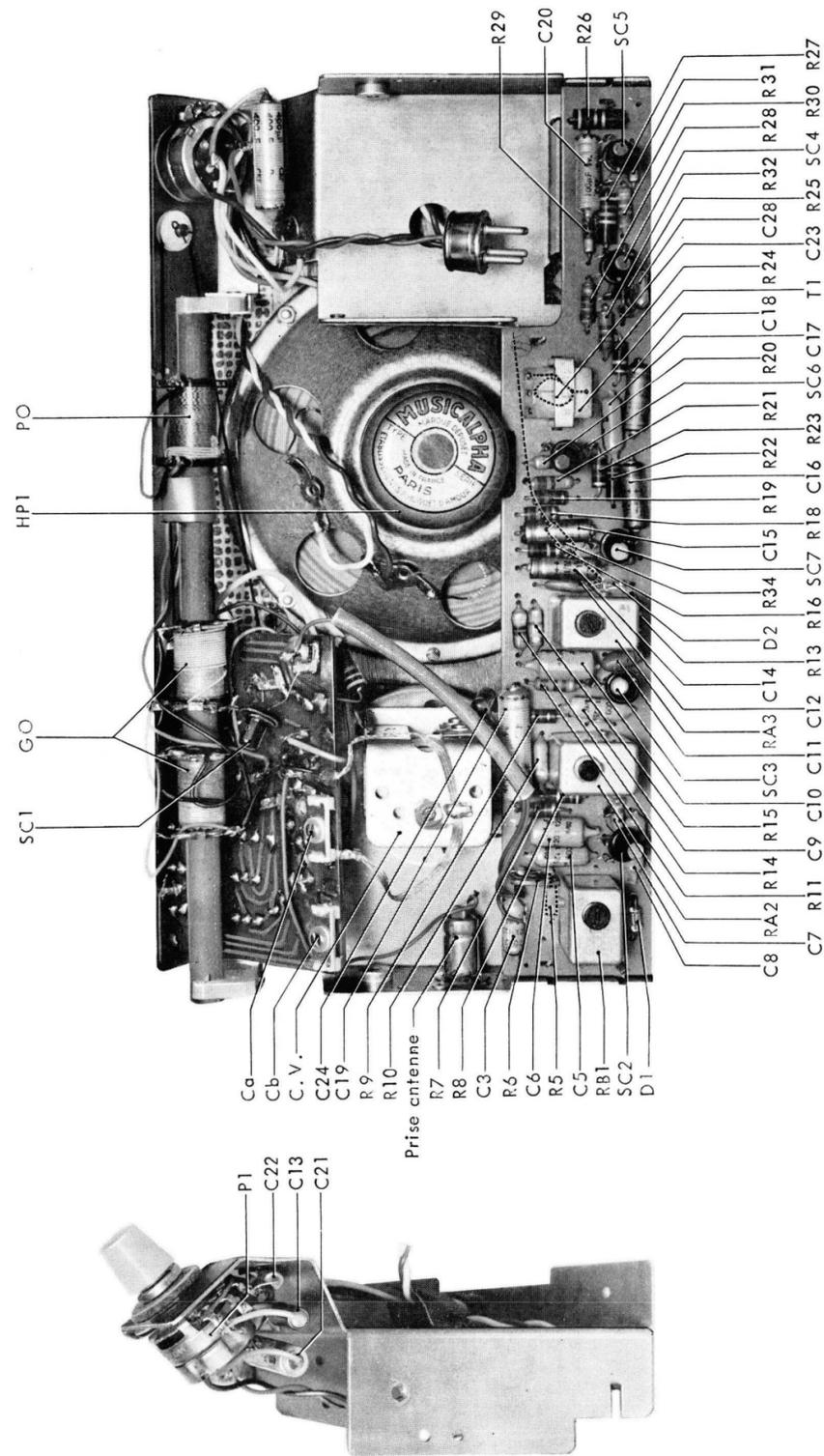
TRANSISTOR "SPORT 2"



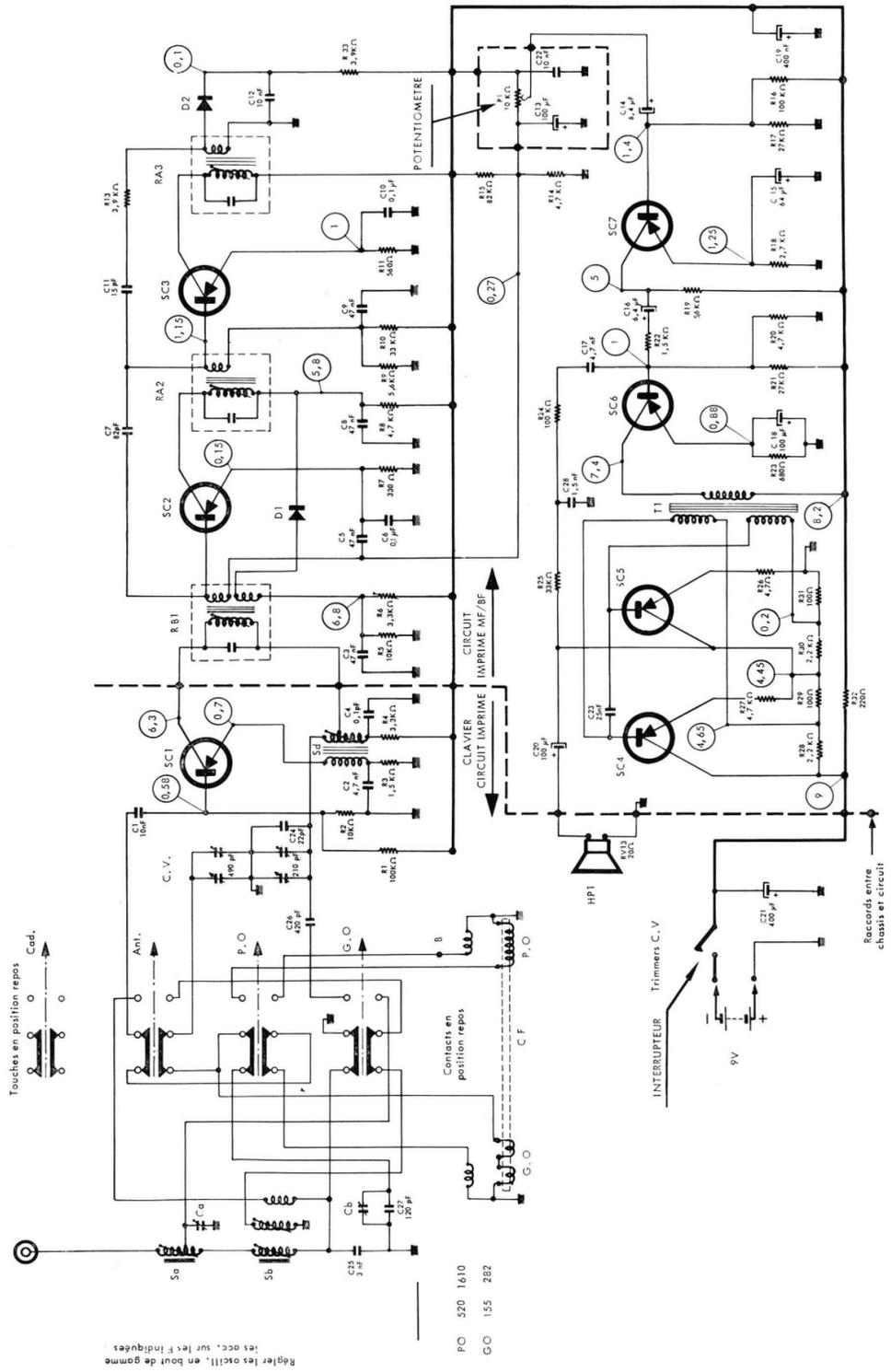
I. – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Récepteur portable : PO : 186 à 576 m.
GO : 1.070 à 1.940 m.
- 7 transistors P.N.P.
- 2 diodes au germanium.
- Cadre ferrite de 200 mm.
- Sélecteur 4 touches : Antenne - Cadre - PO - GO.
- Fréquence intermédiaire : 477 kc/s.
- Étage final push-pull sans transformateur.
- Puissance de sortie : 325 mW.
- Haut-parleur 12 cm.
- Prise pour antenne voiture ou antenne extérieure
- Alimentation par 2 piles standard de 4,5 V couplées dans un boîtier isolant.
- Câblage imprimé.
- Coffret, gainage plastique gris clair.
- Dimensions : Longueur 280 mm. Profondeur 95 mm. Hauteur 175 mm.
- Poids : 2.100 g.

VUE ARIÈRE ET PROFIL



SCHEMA DE PRINCIPE



NOMENCLATURE

REP.	DÉSIGNATION	CODE	REP.	DÉSIGNATION	CODE
CONDENSATEURS :					
C 1	Céram. 10 nF		R 13	3,9 KΩ	
C 2	Céram. 4,7 nF		R 14	4,7 KΩ	
C 3	Céram. 47 nF 125 V		R 15	82 KΩ ± 5 %	1/4 W min. isolée
C 4	Céram. 0,1 μF		R 16	100 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée
C 5	Céram. 47 nF 125 V		R 17	27 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée
C 6	Céram. 0,1 μF 125 V		R 18	2,7 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée
C 7	Céram. 82 pF		R 19	5,6 KΩ ± 5 %	1/4 W min. isolée
C 8	Céram. 47 nF 125 V		R 20	4,7 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée
C 9	Céram. 47 nF 125 V		R 21	27 KΩ	min. isolée
C 10	Céram. 0,1 μF 125 V		R 22	1,5 KΩ	
C 11	Céram. 15 pF		R 23	680 Ω ± 10 %	
C 12	Céram. 10 nF		R 24	100 KΩ	
C 13	Chimique 100 μF 4 V		R 25	33 KΩ	1/2 W min. isolée
C 14	Chimique 6,4 μF 40 V		R 26	4,7 Ω	1/2 W min. isolée
C 15	Chimique 64 μF 10 V		R 27	4,7 Ω	1/2 W min. isolée
C 16	Chimique 6,4 μF 40 V		R 28	2,2 KΩ	1/4 W min. isolée
C 17	Chimique 4,7 nF 400 V		R 29	100 Ω	
C 18	Chimique 100 μF 4 V		R 30	2,2 KΩ	
C 19	Chimique 400 μF 9 V		R 31	100 Ω	
C 20	Chimique 100 μF 9 V		R 32	220 Ω	
C 21	Chimique 400 μF 9 V		R 33	3,9 KΩ	
C 22	Chimique 10 nF 125 V		DIVERS :		
C 23	Céram. 25 nF		P 1	Potentiomètre 10 KΩ	
C 24	Céram. 22 pF		RA 2	Transformateur FI blanc	
C 25	Céram. 3 nF		RA 3	Transformateur FI rouge	
C 26	Mica 420 pF		RB 1	Transformateur FI noir	
C 27	Céram. 120 pF		H.P.1	Haut-parleur	
C 28	Céram. 1,5 nF		C.F.	Cadre ferrite	
C.V.	Condensateur variable		D 1	SFD 106 W	
R 1	100 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée	D 2	SFD 106 W	
R 2	10 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée	Sa	Acc. Ant. GO	
R 3	1,5 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée	Sb	Acc. Ant. PO	
R 4	3,3 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée	Sd	Osc. PO-GO	
R 5	10 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée	Sc 1	Transistor SFT 108	
R 6	Ajustable 3,3 KΩ	1/4 W	Sc 2	Transistor SFT 107	
R 7	330 Ω ± 10 %	1/4 W min. isolée	Sc 3	Transistor SFT 106	
R 8	4,7 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée	Sc 4	Transistor SFT 123	
R 9	5,6 KΩ ± 5 %	1/4 W min. isolée	Sc 5	Transistor SFT 123	
R 10	33 KΩ ± 10 %	1/4 W min. isolée	Sc 6	Transistor SFT 153	
R 11	560 Ω ± 10 %	1/4 W min. isolée	Sc 7	Transistor SFT 152	
			T 1	Transformateur BF déphaseur Oréga 1071 D	

